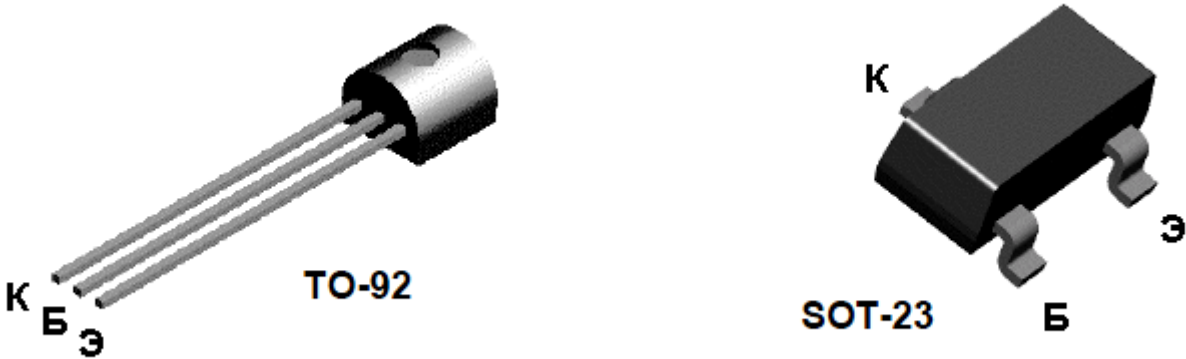


2N5551

Кремниевый биполярный эпитаксиально-планарный n-p-n транзистор.

Предназначен для использования в высокочастотных устройствах аппаратуры широкого применения с малым уровнем шумов и повышенным напряжением питания.
Отечественный аналог КТ6117А.



Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации при Токр. среды = 25 °С.

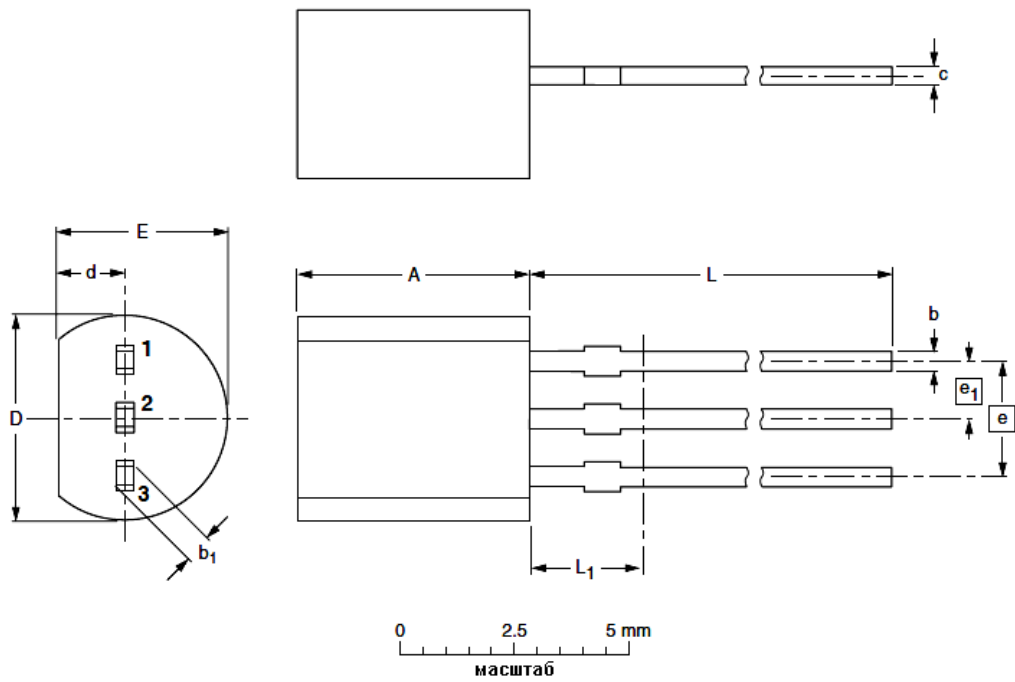
Обозначение	Параметр	Значение	Единицы измерения
Укб max	Напряжение коллектор-база	160	В
Укэ max	Напряжение коллектор-эмиттер	180	В
Уэб max	Напряжение эмиттер-база	6	В
Ik max	Постоянный ток коллектора	600	мА
Tj	Температура перехода	150	°С

Тепловые характеристики при Токр. среды = 25 °С.

Обозначение	Параметр	Значение		Единицы измерения
		TO-92	SOT-23	
Pk max	Рассеиваемая мощность коллектора	0.625	0.350	Вт
Rthj-case	Тепловое сопротивление кристалл-корпус	83.3		°С/Ват
Rthj-amb	Тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда	200	357	°С/Ват

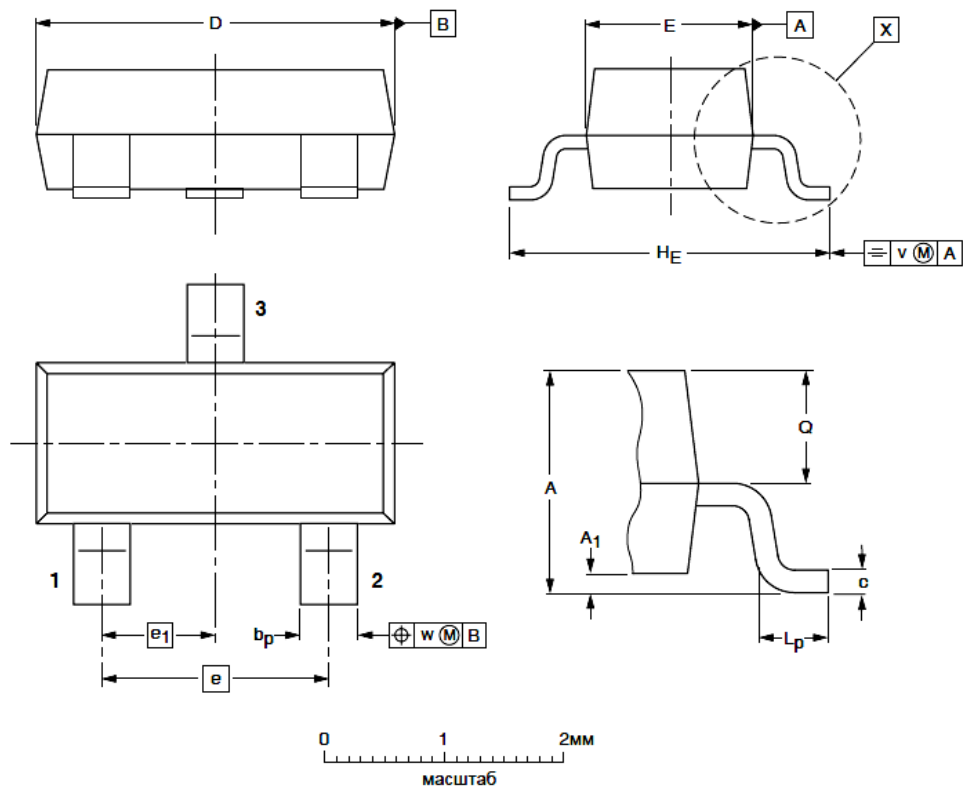
Электрические характеристики при Токр. среды = 25 °С.

Обозначение	Параметр	Условия испытания	Мин.	Макс.	Единицы измерения
Укэ(проб.)	Напряжение пробоя коллектор-эмиттер	Ik=1.0мА, IБ=0	160		В
Укб(проб.)	Напряжение пробоя коллектор-база	Ik=100мкА, IЭ=0	180		В
Уэб(проб.)	Напряжение пробоя эмиттер-база	IЭ=10мкА, Ik=0	6		В
Ikбо	Обратный ток коллектора	Укб=120В, IЭ=0 Укб=120В, IЭ=0, ТА=100°С		50 50	нА мкА
Iэбо	Обратный ток эмиттера	Уэб=4В, Ik=0		50	нА
h21э	Статический коэффициент передачи тока	Ik=1.0 мА, Укэ=5.0В Ik=10 мА, Укэ=5.0В Ik=50 мА, Укэ=5.0В	80 80 30	250	
Укэ(нас)	Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	Ik=10мА, IБ=1мА Ik=50мА, IБ=5мА		0.15 0.2	В
Уэб(нас)	Напряжение насыщения база-эмиттер	Ik=10мА, IБ=1мА Ik=50мА, IБ=5мА		1.0 1.0	В
fгр.	Граничная частота коэф. передачи тока	Укэ=10В, Ik=10мА, f=100МГц	100	300	МГц
Ск	Емкость коллекторного перехода	Укб=10В, IЭ=0, f=1мГц		6.0	пФ
Кш	Коэффициент шума	Ik=250мкА, Укэ=5.0В, Rс=1.0 кОм, f=10Гц до 15.7 кГц		8.0	дБ



Размеры (мм, оригинальный размер)

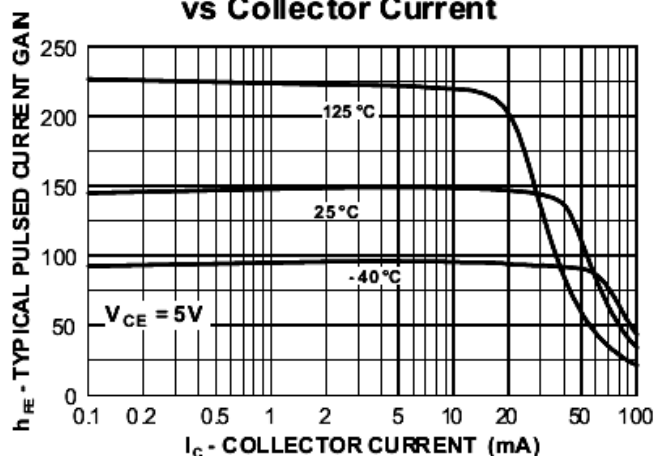
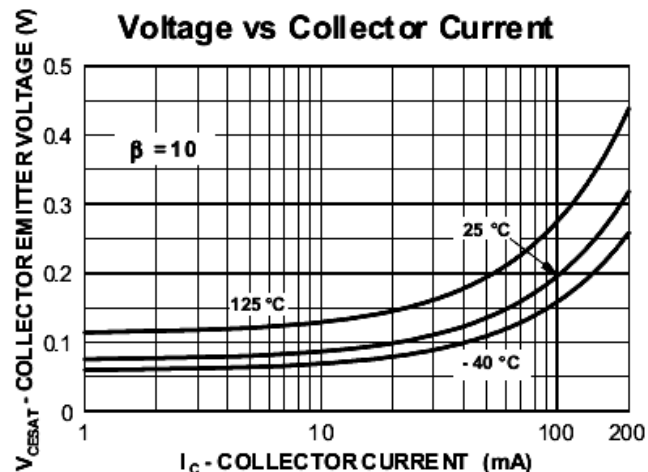
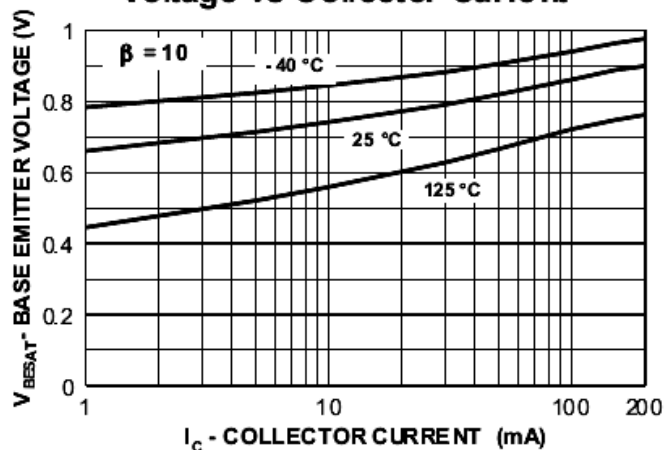
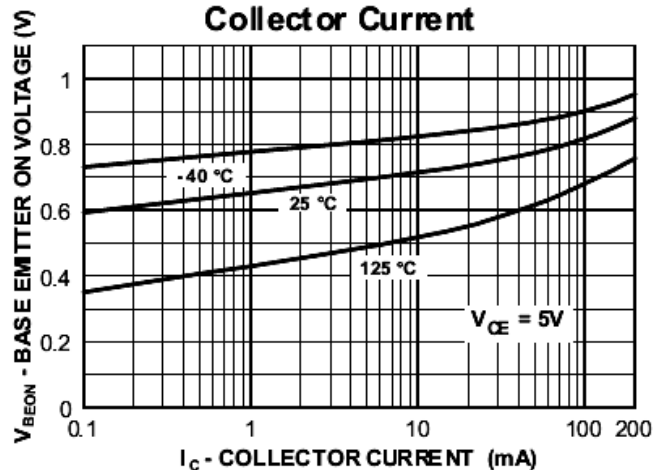
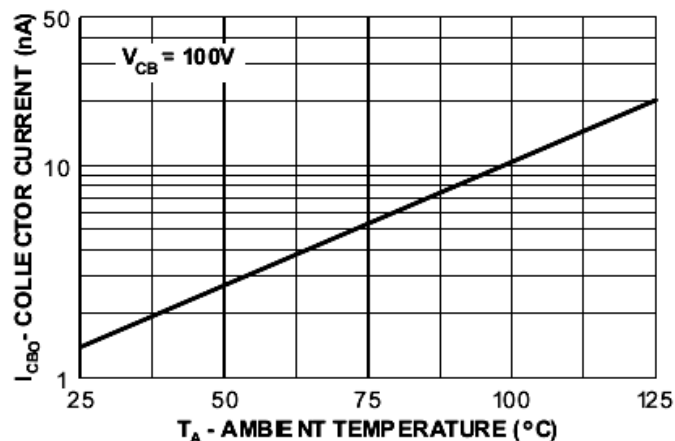
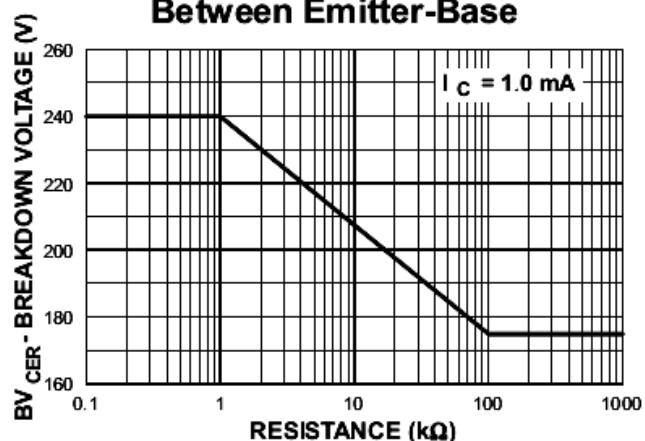
Ед. измерения	A	b	b ₁	c	D	d	E	e	e ₁	L	L ₁ ⁽¹⁾ max.
мм	5.2 5.0	0.48 0.40	0.66 0.55	0.45 0.38	4.8 4.4	1.7 1.4	4.2 3.6	2.54	1.27	14.5 12.7	2.5



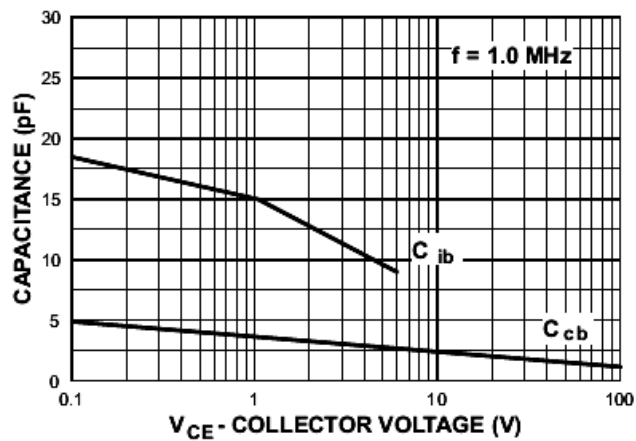
Размеры (мм, оригинальный размер)

Ед. измерения	A	A ₁ max.	b _p	c	D	E	e	e ₁	H _E	L _p	Q	v	w
мм	1.1 0.9	0.1	0.48 0.38	0.15 0.09	3.0 2.8	1.4 1.2	1.9	0.95	2.5 2.1	0.45 0.15	0.55 0.45	0.2	0.1

Графики характеристик

Typical Pulsed Current Gain
vs Collector CurrentCollector-Emitter Saturation
Voltage vs Collector CurrentBase-Emitter Saturation
Voltage vs Collector CurrentBase Emitter ON Voltage vs
Collector CurrentCollector-Cutoff Current
vs. Ambient TemperatureCollector-Emitter Breakdown
Voltage with Resistance
Between Emitter-Base

Графики характеристик

Input and Output Capacitance
vs Reverse VoltageSmall Signal Current Gain
vs Collector Current